

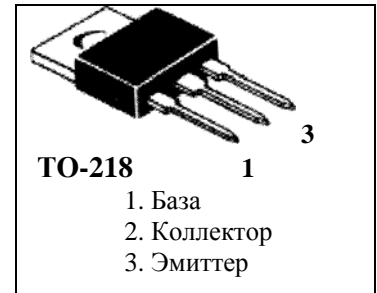
**PNP КРЕМНИЕВЫЙ ЭПИТАКСИАЛЬНО - ПЛАНАРНЫЙ  
СОСТАВНОЙ ТРАНЗИСТОР С ИНТЕГРАЛЬНЫМИ  
ДЕМПФИРУЮЩИМ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫМ ДИОДАМИ**

АДБК.432140.818 ТУ

ИСО 9001-2001

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАБОТЫ В СХЕМАХ ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ, УЗЛАХ И БЛОКАХ АППАРАТУРЫ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

- \* Рабочий температурный диапазон: - 45°C ÷ +125°C
- \* Зарубежный аналог - **BU941ZP**
- \* Изготавливается в корпусе **КТ-43 (ТО-218)**.



**ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

| Параметры                             | Обозначение | Ед. изм. | Значение |
|---------------------------------------|-------------|----------|----------|
| Напряжение коллектор-эмиттер          | Uкэо max    | В        | 350      |
| Напряжение эмиттер-база               | Uэб max     | В        | 5        |
| Постоянный ток коллектора             | Iк max      | А        | 15       |
| Импульсный ток коллектора             | Iки max     | А        | 30       |
| Постоянный ток базы                   | Iб max      | А        | 1        |
| Импульсный ток базы                   | Iби max     | А        | 5        |
| Рассеиваемая мощность коллектора:     | Рк max      | Вт       | 155      |
| Температура перехода                  | Tj          | °С       | 175      |
| Тепловое сопротивление переход-корпус | Rt пер-кор  | °С/Вт    | 0.97     |

**ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (Токр.ср.=25°С)**

| Параметры                                       | Обознач.          | Ед, измер | Режим измерения                       | Мин    | Макс |
|---|-------------------|-----------|---------------------------------------|--------|------|
| Обратный ток коллектор-эмиттер                  | Iкэо              | мА        | Uкэ=300В, Iб=0                        |        | 0.1  |
| Обратный ток эмиттера                           | Iэбо              | мА        | Uэб= 5В, Iк=0                         |        | 20   |
| Напряжение насыщения коллектор - эмиттер (1)    | Uкэ (нас)         | В         | Iк=8А, Iб=100мА                       |        | 1.8  |
|   |                   |           | Iк=10А, Iб=250мА                      |        | 1.8  |
|   |                   |           | Iк=12А, Iб=300мА                      |        | 2.0  |
| Напряжение насыщения база-эмиттер(1)            | Uбэ (нас)         | В         | Iк=8А, Iб=100мА                       |        | 2.2  |
|   |                   |           | Iк=10А, Iб=250мА                      |        | 2.5  |
|   |                   |           | Iк=12А, Iб=300мА                      |        | 2.7  |
| Статический коэффициент передачи тока (1,2)     | h21Э              |           | Uкэ=10В, Iк=5А                        | 300    |      |
| Граничное напряжение коллектор - эмиттер        | Uкэо гр           | В         | Iк=100мА, Iб=0<br>tu ≤300 мкс, Q ≥100 | 350    | 500  |
| Прямое напряжение на диоде                      | Uпр.д             | В         | Iэ=10А                                |        | 2.5  |
| Время:                    рассасывания<br>спада | трас. *<br>тсп. * | мкс       | Iк=7А, Uкэ=300В,<br>Iб1= Iб2=70мА     | типов. | 15   |
|   |                   |           |                                       |        | 0.5  |
| Импульсная энергия на индуктивной нагрузке      | Еимп.*            | мДж       | Iк=10А, Uк=24В,<br>L=7мГн             | 350    |      |

- \* - Справочные параметры,   (1) Импульсный режим: tu ≤300 мкс, Q ≥50,
- (2) Режим измерения для схемы с общей базой: Uкб= 7.5В, Iэ=Iк

